CWDM3011P

SURFACE MOUNT SILICON P-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET



www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CWDM3011P is a high current silicon P-Channel enhancement-mode MOSFET designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET has high current capability with beneficially low $r_{DS(ON)}$, and low gate charge.



SOIC-8 CASE

APPLICATIONS:

- Load/Power switches
- DC-DC converter circuits
- Power management

FEATURES:

- Low rDS(ON)
- High current
- Low gate charge

MARKING CODE: C3011P

MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C)	SYMBOL		UNITS
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	20	V
Continuous Drain Current (Steady State)	Ι _D	11	Α
Maximum Pulsed Drain Current, tp=10µs	I_{DM}	50	Α
Power Dissipation	P_{D}	2.5	W
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-55 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ.ΙΔ	50	°C/W

EL EGEDIGAL GUADAGEDIGEIGG	T 0500 I II I
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($1_{\Delta}=25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

ELECTRICAL C	THARACTERISTICS. (1A-23 C ui	liess offici wise	Hoteu)		
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I _{GSSF} , I _{GSSR}	V_{GS} =20V, V_{DS} =0			100	nA
I _{DSS}	V_{DS} =30V, V_{GS} =0			1.0	μΑ
BV _{DSS}	$V_{GS}=0$, $I_D=250\mu A$	30			V
V _{GS(th)}	$V_{GS}=V_{DS}$, $I_{D}=250\mu A$	1.0	1.4	3.0	V
V_{SD}	$V_{GS} = 0, I_{S} = 2.6A$			1.3	V
rDS(ON)	V _{GS} =10V, I _D =11A		12	20	$m\Omega$
rDS(ON)	V_{GS} =4.5V, I_D =8.5A		15	30	$m\Omega$
C _{rss}	V_{DS} =8.0V, V_{GS} =0, f=1.0MHz		450		pF
C _{iss}	V_{DS} =8.0V, V_{GS} =0, f=1.0MHz		3100		pF
C _{oss}	V_{DS} =8.0V, V_{GS} =0, f=1.0MHz		320		pF
Q _{g(tot)}	V_{DD} =15V, V_{GS} =10V, I_{D} =11A		80		nC
Q _{gs}	V_{DD} =15V, V_{GS} =10V, I_{D} =11A		7.0		nC
Q_{gd}	V_{DD} =15V, V_{GS} =10V, I_{D} =11A		10.1		nC
ton	V_{DD} =15V, V_{GS} =10V, I_{D} =1.0A		49		ns
t _{off}	$R_G=6.0\Omega$, $R_L=15\Omega$		330		ns

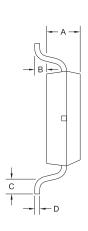
R1 (6-August 2013)

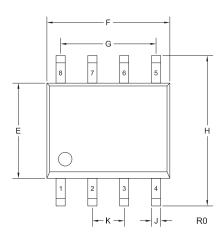
CWDM3011P

SURFACE MOUNT SILICON P-CHANNEL **ENHANCEMENT-MODE MOSFET**



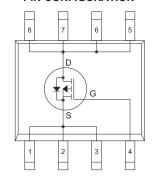
SOIC-8 CASE - MECHANICAL OUTLINE





DIMENSIONS					
	INCHES		MILLIMETERS		
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX	
Α	0.049	0.057	1.24	1.44	
В	0.000	0.011	0.00	0.27	
С	0.018	-	0.46	-	
D	0.006	0.011	0.16	0.27	
E	0.145	0.154	3.70	3.90	
F	0.189	0.198	4.81	5.01	
G	0.150		3.81		
Н	0.231	0.244	5.88	6.18	
J	0.013	0.021	0.35	0.52	
K	0.050		1.27		
SOIC-8 (REV: R0)					

PIN CONFIGURATION



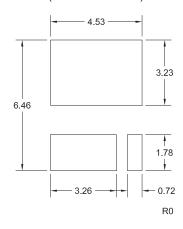
LEAD CODE:

1) Source 5) Drain 6) Drain 2) Source 3) Source 7) Drain 4) Gate 8) Drain

MARKING CODE: C3011P

SUGGESTED MOUNTING PADS

(Dimensions in mm)



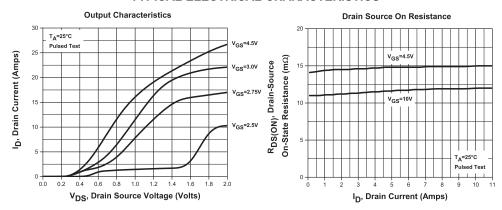
R1 (6-August 2013)

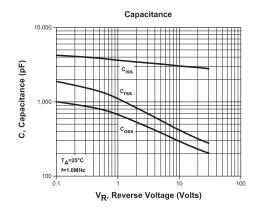
CWDM3011P

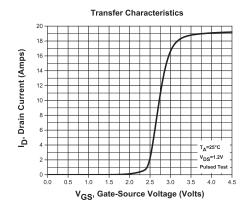
SURFACE MOUNT SILICON P-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET

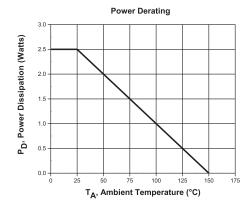


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS









R1 (6-August 2013)

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9